

HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR

- STMicroelectronics PREFERRED SALES TYPE
- NPN TRANSISTOR
- HIGH VOLTAGE CAPABILITY
- LOW SPREAD OF DYNAMIC PARAMETERS
- MINIMUM LOT-TO-LOT SPREAD FOR RELIABLE OPERATION
- VERY HIGH SWITCHING SPEED
- FULLY CHARACTERIZED AT 125°C

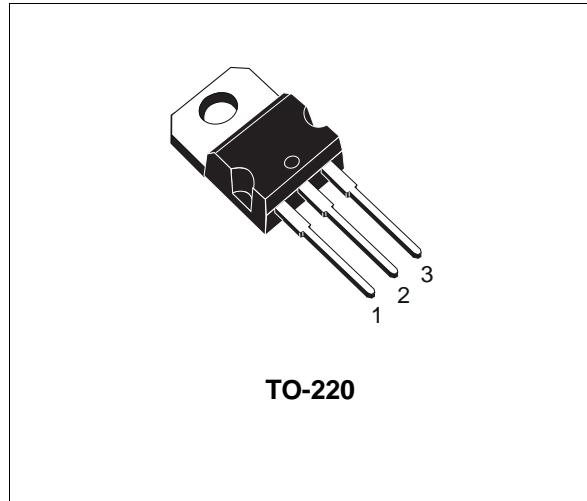
APPLICATIONS

- ELECTRONIC BALLASTS FOR FLUORESCENT LIGHTING
- FLYBACK AND FORWARD SINGLE TRANSISTOR LOW POWER CONVERTERS

DESCRIPTION

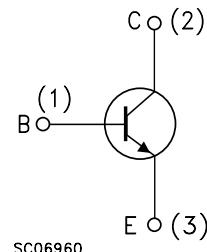
The BUL138 is manufactured using high voltage Multi Epitaxial Planar technology for high switching speeds and high voltage capability. It uses a Cellular Emitter structure with planar edge termination to enhance switching speeds.

The BUL series is designed for use in lighting applications and low cost switch-mode power supplies.



TO-220

INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CES}	Collector-Emitter Voltage ($V_{BE} = 0$)	800	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	400	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)	9	V
I_C	Collector Current	5	A
I_{CM}	Collector Peak Current ($t_p < 5 \text{ ms}$)	10	A
I_B	Base Current	2	A
I_{BM}	Base Peak Current ($t_p < 5 \text{ ms}$)	4	A
P_{tot}	Total Dissipation at $T_c = 25^\circ\text{C}$	80	W
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 150	$^\circ\text{C}$
T_j	Max. Operating Junction Temperature	150	$^\circ\text{C}$

BUL138

THERMAL DATA

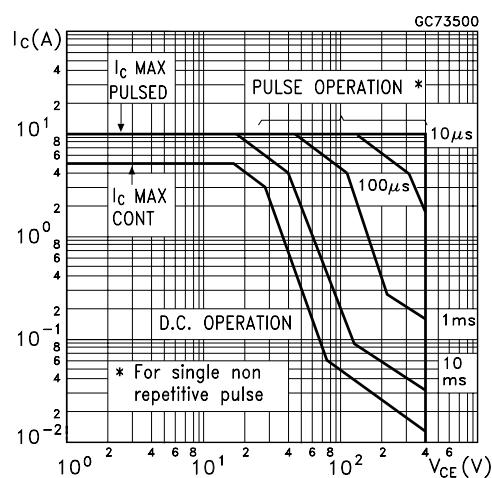
R _{thj-case}	Thermal Resistance Junction-case	Max	1.56	°C/W
R _{thj-amb}	Thermal Resistance Junction-ambient	Max	62.5	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{case} = 25$ °C unless otherwise specified)

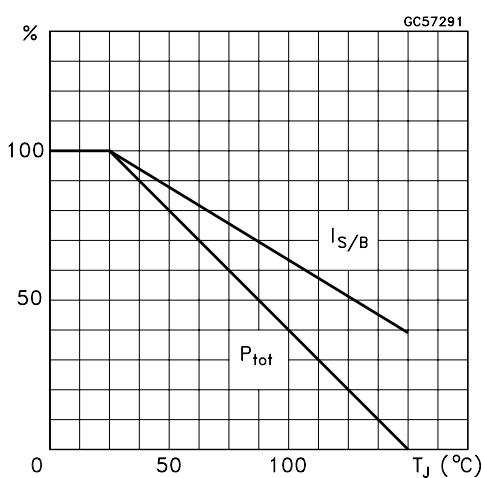
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I _{CES}	Collector Cut-off Current ($V_{BE} = 0$)	$V_{CE} = 800$ V $V_{CE} = 800$ V $T_j = 125$ °C			100 500	μA μA
I _{CEO}	Collector Cut-off Current ($I_B = 0$)	$V_{CE} = 400$ V			250	μA
V _{CEO(sus)}	Collector-Emitter Sustaining Voltage	$I_C = 100$ mA $L = 25$ mH	400			V
V _{EBO}	Emitter-Base Voltage	$I_E = 10$ mA	9			V
V _{CE(sat)*}	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 1$ A $I_B = 0.2$ A $I_C = 2$ A $I_B = 0.4$ A $I_C = 3$ A $I_B = 0.6$ A $I_C = 4$ A $I_B = 1$ A $I_C = 5$ A $I_B = 1$ A		0.7	0.5 0.7 1 1	V
V _{BE(sat)*}	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 1$ A $I_B = 0.2$ A $I_C = 2$ A $I_B = 0.4$ A $I_C = 3$ A $I_B = 0.6$ A			1.1 1.3 1.5	V
h_{FE}^*	DC Current Gain	$I_C = 2$ A $V_{CE} = 5$ V $I_C = 10$ mA $V_{CE} = 5$ V	8 10		40	
t _s	RESISTIVE LOAD Storage Time	$I_C = 2$ A $I_{B1} = -I_{B2} = 0.4$ A $V_{CC} = 250$ V	2.4		3.5	μs
t _s t _f	INDUCTIVE LOAD Storage Time Fall Time	$I_C = 2$ A $I_{B1} = 0.4$ A $V_{BE(off)} = -5$ V $R_{BB} = 0$ Ω $V_{CL} = 250$ V $L = 200$ μH		0.7 50	1.4 100	μs ns
t _s t _f	INDUCTIVE LOAD Storage Time Fall Time	$I_C = 2$ A $I_{B1} = 0.4$ A $V_{BE(off)} = -5V$ $R_{BB} = 0$ Ω $V_{CL} = 250$ V $L = 200$ μH $T_j = 125$ °C		1 75		μs ns

* Pulsed: Pulse duration = 300 μs, duty cycle 1.5 %

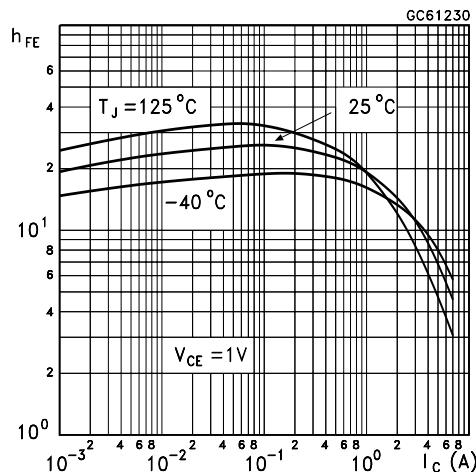
Safe Operating Areas



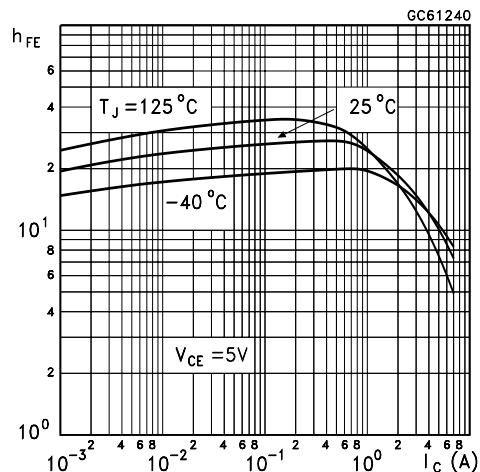
Derating Curve



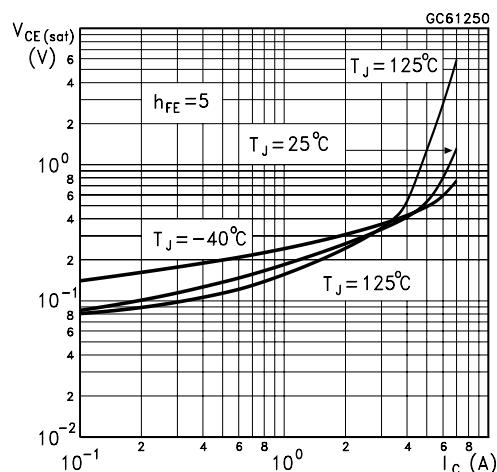
DC Current Gain



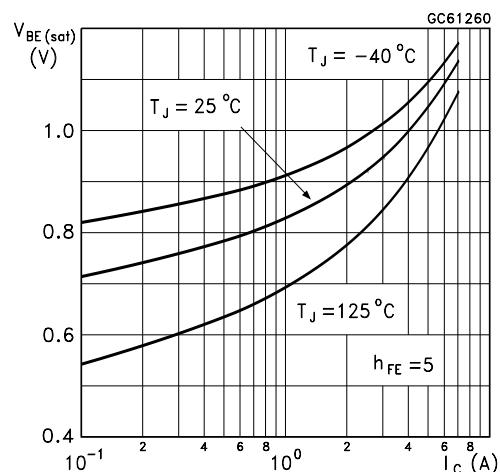
DC Current Gain



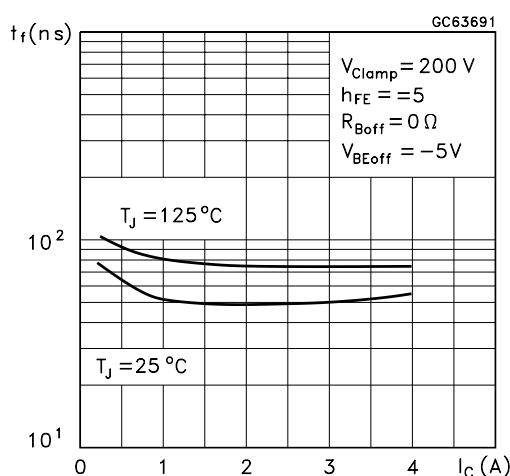
Collector-Emitter Saturation Voltage



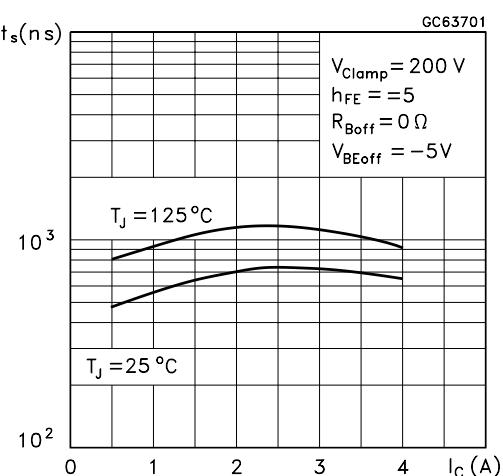
Base-Emitter Saturation Voltage



Inductive Fall Time

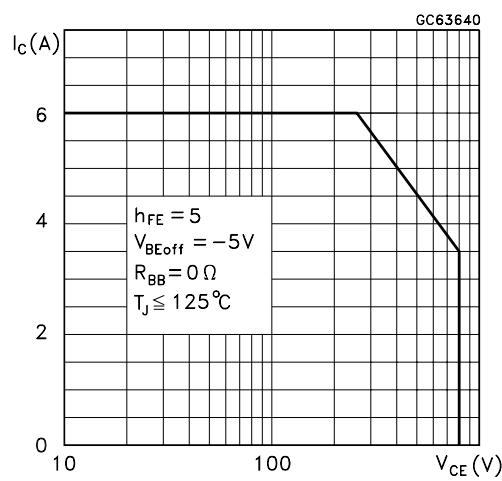


Inductive Storage Time

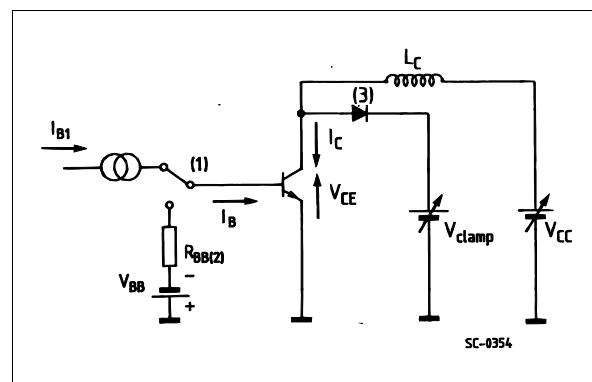


BUL138

Reverse Biased SOA



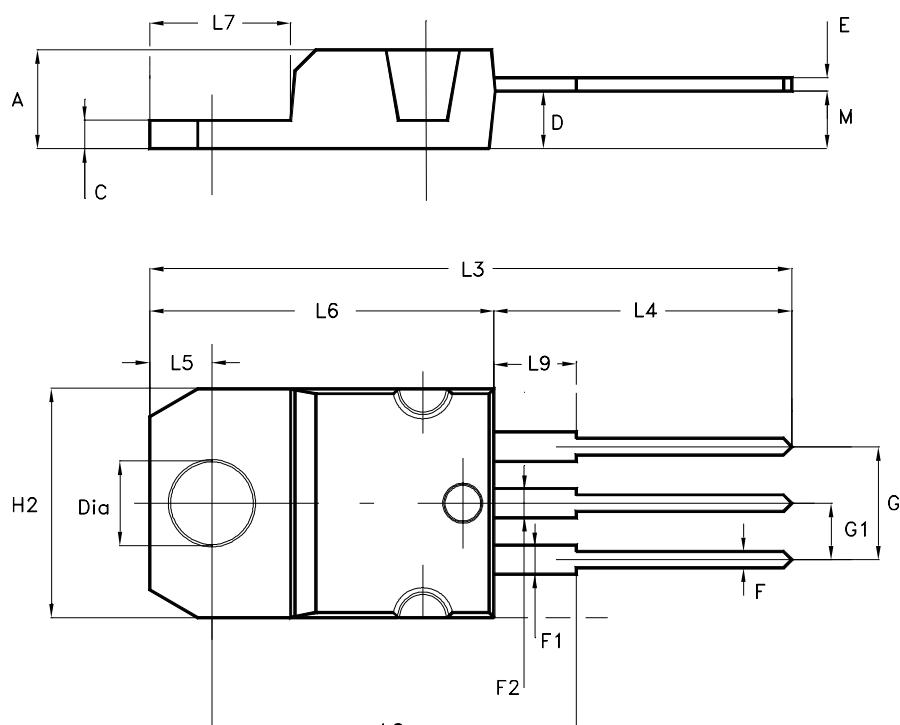
RBSOA and Inductive Load Switching Test Circuits



- 1) Fast electronic switch
- 2) Non-inductive Resistor
- 3) Fast recovery rectifier

TO-220 MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.40		4.60	0.173		0.181
C	1.23		1.32	0.048		0.052
D	2.40		2.72	0.094		0.107
E	0.49		0.70	0.019		0.027
F	0.61		0.88	0.024		0.034
F1	1.14		1.70	0.044		0.067
F2	1.14		1.70	0.044		0.067
G	4.95		5.15	0.194		0.202
G1	2.40		2.70	0.094		0.106
H2	10.00		10.40	0.394		0.409
L2		16.40			0.645	
L4	13.00		14.00	0.511		0.551
L5	2.65		2.95	0.104		0.116
L6	15.25		15.75	0.600		0.620
L7	6.20		6.60	0.244		0.260
L9	3.50		3.93	0.137		0.154
M		2.60			0.102	
DIA.	3.75		3.85	0.147		0.151



P011CI

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics

© 2001 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved
STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco -
Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - U.S.A.

<http://www.st.com>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331